PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-053956

(43)Date of publication of application: 22.02.2000

(51)Int CI

C09K 11/06 H05B 33/14

(21)Application number: 10-225504

(71)Applicant: TOYO INK MFG CO LTD

(72)Inventor: TAMANO MICHIKO (22)Date of filing: 10 08 1998

ONIKUBO SHUNICHI

(54) LUMINESCENT MATERIAL FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SQLVED: To obtain a new compound useful as a luminescent material for an organic electroluminescence element having high luminescent luminance and excellent stability in repeating use. including an aryl group-containing substituting group. SOLUTION: This luminescent material is a compound of formula I R1-R6 are each H, a halogen, an alkyl, NR7R8 (R7 and R8 are each an alkyl or an aryl) or the like, more than two of R1-R6 are each NR7R8], e.g. a compound of formula II. To obtain the compound of formula I, e.g. dibromoguinoxaline or iodoguinoxaline is reacted with an aromatic diamine compound in nitrobenzene as solvent together with a catalyst such as potassium carbonate at 200° C. The compound of formula I has a strong fluorescent light in a solid state and excellent in an electric field luminescent property and may be used as a luminescent material in a luminescent layer. Preferably, the compound is contained in the luminescent layer in an amount of 0.01-10 wt.% per a host material.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-53956 (P2000-53956A)

(43)公開日 平成12年2月22日(2000.2.22)

(51) Int.Cl.7	裁別記号	FI	,	テーマコード(参考)
C 0 9 K 11/06	650	C09K 11/06	650	3 K 0 0 7
H 0 5 B 33/14	7	H 0 5 B 33/14	В	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特顯平10-225504	(71)出願人 000222118
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	time of bear by	東洋インキ製造株式会社
(22)出順日	- 平成10年8月10日(1998.8.10)	東京都中央区京橋2丁目3番13号
	wiley, the transfer	(72)発明者 玉野、美智子
- mar 1	A STATE OF A STATE OF THE STATE	東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ
2 -115 192	THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.	ンキ製造株式会社内
+	and the state of t	(72)発明者 鬼久保。俊一
	4.	東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ
Agg - t to	158 7 145	ンキ製造株式会社内
	# 2 \$1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fターム(参考) 3K007 AB00 AB02 AB03 AB06 CA01
h 7.74 c.	HIRTON AND LONG LONG	CB01 DA00 DA01 DB03 EB00
	Service Control of the Service Control	FA01
17 9 00,21	Sport was the first part of the	and the second of the second o
1 22 1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料およびそれを使用した有機エレクトロルミネッセ port of a ンス素子 to a contract the contract to a contract thing a first - but have

(57)【要約】

【課題】発光輝度が高く、繰り返し使用時での安定性の 優れた有機EL素子の提供することを目的とする。 【解決手段】一般式 [1] で示される有機エレクトロル ミネッセンス素子用発光材料。

一般式「1]

[{£1]

$$R^5$$
 N
 R^1
 R^2

[式中、R1~R6は、それぞれ独立に-NR7R8、 (R7、R8は、置換もしくは未置換のアルキル基、置換 もしくは未置換のアリール基を表わし、R7とR8が一体 となってもよい。)、水素原子、ハロゲン原子、置換も しくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアル コキシ基、置換もしくは未置換のアリールオキシ基、置 換もしくは未置換のアルキルチオ基、置換もしくは未置

換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリール基 を表わす (ただし、R1~R6の2個以上は-NR7R8を 示す。)。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式[1]で示される有機エレクト ロルミネッセンス素子用発光材料。

一般式 [1]

【化1】

[式中、R1~R6は、それぞれ独立に-NR7R8:、:

 $(R^7$ 、 R^8 は、置換もしくは未置換のアルキル基、置換 もしくは未置換のアリール基を表わし、R7とR8が一体 となってもよい。)、水水素原子、ハロゲン原子、置換も しくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアル コキシ基、置換もしくは未置換のアリールオギシ基、置 換もしくは未置換のアルギルチオ基準置換もしくは未置 換のアリールチオ基、置換もしくは未置換のアリール基 を表わす (ただし、R1~R6の2個以上は-NR7R8を 示する) ごりつくけい かん 一切が深たる

【請求項2】一般式 [1] の少なくともR3とR6、また は少なくともRTとR4が、一NR7 R8である請求項1 記載の発光材料。

【請求項3】ホスト材料と上記一般式[1]で示される 化合物とからなる有機エレクトロルミネッセンス素子用 発光材料。

【請求項4】一対の電極間に発光層を含む複数層の有機 化合物強膜を形成した有機エレクトロルミネッセンス素 子において、発光層が請求項1~3いずれか記載の有機 エレクトロルミネッセンス素子用発光材料を含有する層 である有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は平面光源や表示に使用さ れる有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子用発光 材料および高輝度の発光素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用したEL素子は、固体発 光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が 有望視され、多くの開発が行われている。一般にEL素 子は、発光層および該層をはさんだ一対の対向電極から 構成されている。発光は、両電極間に電界が印加される と、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入 される。さらに、この電子が発光層において正孔と再結 合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際に エネルギーを光として放出する現象である。

【OOO3】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比 べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。 また、特性劣化も著しく実用化には至っていなかった。

近年、10 V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率 を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機EL 素子が報告され、関心を集めている(アプライド・フィ ジクス・レターズ、51巻、913ページ、1987年 参照)。この方法は、金属キレート錯体を発光層、アミ ン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発光 を得ており、6~7Vの直流電圧で輝度は数1000c d/m²、最大発光効率は 1.5 l m/Wを達成して、 実用領域に近い性能を持っている。

【0004】しかしながら、現在までの有機EL素子 は、構成の改善により発光強度は改良されているが、未 だ充分な発光輝度は有していない。また、繰り返し使用 時の安定性に劣るという大きな問題を持っている。これ は、例えば、トリス (8-ヒドロキシキノリナート) ア ルミニウム錯体等の金属キレート錯体が、電界発光時に 化学的に不安定であり: 陰極との密着性も悪く: 短時間 の発光で大きく劣化していた。以上の理由により、高い 発光輝度、発光効率を持ち、繰り返し使用時での安定性 の優れた有機EL素子の開発のために、優れた発光能力 を有し、耐久性のある発光材料の開発が望まれている。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、発光輝度が 高く、繰り返し使用時での安定性の優れた有機EL素子 の提供にある。本祭明者らが鋭意検討した結果、一般式

[1] で示される有機EL素子用発光材料を発光層に使 用した有機EL素子の発光輝度および発光効率が高く、 繰り返し使用時での安定性も優れていることを見いだし 本発明を成すに至った。

[0006] for the 1985 and and the

[課題を解決するための手段] 本発明は、下記一般式 [1] で示される有機エレクトロルミネッセンス素子用 発光材料に関する。 一般式:[1]

[0007] [化2]

【0008】 [式中、R1~R6は、それぞれ独立に-N R7R8 、 (R7、R8は、置換もしくは未置換のアルキ ル基、置換もしくは未置換のアリール基を表わし、R7 とR8が一体となってもよい。)、水素原子、ハロゲン 原子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは 未置換のアルコキシ基、置換もしくは未置換のアリール オキシ基、置換もしくは未置換のアルキルチオ基、置換 もしくは未置換のアリールチオ基、置換もしくは未置換 のアリール基を表わす(ただし、 $R^1 \sim R^6$ の2個以上は - N R ⁷ R ⁸を示す。)。]

[0009] さらに、本祭明は一般式 [1] の少なくと もR3とR6、または少なくともR1とR4が、一NR7 R 8である上記を対料に関する。さらに、本発明はホスト材料と上記一般式 [1] で示される化合物からなる有 様エレクトロルミネッセンス素子用ドーピング発光材料 に関する。さらに、本発明は一対の電極関に発光層を む複数層の有機化合物薄膜を形成した有機エレクトロル ミネッセンス素子において、発光層が上記有機エレクト ロルミネッセンス素子用発光材料を含有する層である有 様エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明における一般式 [1] で示される化名物の尺1-R61は、それぞれ独立に一NR7R8 (成尺、R61は、置換もしくは末置換のアルール基、置換もしくは末置換のアリール基を要す。)、水素原子、ハロゲン原子、医換もしくは未置換のアルコキン基、電換もしくは未置換のアルコキン基、電換もしくは未置換のアルールチオ基、電換もしくは未置換のアリールル本を要す。ただし、Rf、直接もしくは未置換のアルキルチオ。 に対している。 に対しいる。 に対しないる。 に対

ーメチルフェニル基、4ーメチルフェニル基、4ーエチルフェニル基、ビフェニル基、4ーメチルビフェニル基、4・メチルビフェニル基、4・シクロロマェニル基、5・ジグロロフェニル基、オーアル基等。デーメチルンチルは、アリール基等の芳香接換素数6~18の電換もしくは未職換のアリール基があめり、さらに、アリール基は、皮素原子が置換されていてもよい。このようなアリール基としては、フラニル基、デオピラニル基、ピオール基、オーダールースを、デオピラニル基、デオピラニル基、デオピラニル基、デリールースを、オーダールールースを、ビアニルールースを、ディーストースを、ディ

【0.0.1.3】 置換もしくは未置換のアリールオキシ基の

具体例としては、フェノキシ基、pーニトロフェノキシ

基、p-teritーブチルフェノキシ基、3-フルオロ フェノキシ基、ペンタフルオロフェニル基、3ートリフ ルオロメチルフェノキシ基等があり、アリールチオ基の 具体例とては、フェニルチオ基、pーニトロフェニルチ オ基、p-tert-ブチルフェニルチオ基、3-フル オロフェニルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基、 3-トリフルオロメチルフェニルチオ基等がある。 【0014】 本発明における一般式 [1] で表される化 合物の-NR7R8 (R7、R8は、置換もしくは未置換の アルキル基、置換もしくは未置換のアリール基を要 す。)のアルキルアミノ基の具体例としては、ジメチル アミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基、ジ ブチルアミノ基、ベンジルアミノ基、ジベンジルアミノ 基等のアルキルアミノ基があり、アリールアミノ基の具 体例としては、フェニルメチルアミノ基、ジフェニルア ミノ基、ジトリルアミノ基、ジビフェニルアミノ基、ジ (4-メチルビフェニル) アミノ基、ジ(3-メチルフ ェニル) アミノ基、ジ (4-メチルフェニル) アミノ 基、ナフチルフェニルアミノ基、ビス [4-(α, α' ージメチルベンジル)フェニル]アミノ基等がある。 【0015】また、R7とR8が一体となって、モルホリ ン環、ビベラジン環、ビベリジン環、ベンゾピペラジン 環、アクリジン環、フェナジン環、ピレニル環、カルバ ゾール環、ベンゾピラニル環、キサンテン環、チアゾリ ル環、チアジン環、ファノチアジン環等の飽和もしくは

【0016] この化合物の中で、一般式 [1] で表されるようなアリール基を有している置換基を持つ化合計 は、ガラス転移点や凝点が高くなり電界発光時における 有機層中、有機層したくは、有機層と金属電極間で発生するジュール熱に対する耐性 耐熱性) が向上するので、有機EL来子の発光材料として使用した場合、高い発光解度を示し、長時間発光させる際にも方剤である本発明の化合物は、これらの置換基に限定されるもので

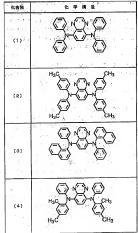
不飽和環を形成してもよい。

はない。

[0018] 一般式 [1] で示される化合物の代表例を 具体的に表 1に例示するが、これらに限定されるもので ばない。

[0019]

【表 1】



[0020]

化合物	化学排运
(5)	883
(6)	H ₂ CO OCH3
က်	888
(8)	888

[0021]

化合物	. 化学構造	
(9)		*
(10)		
(11)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃	

[0022]

化合物	. 化学 横 造	<u> </u>	1	1
(12)	H ₉ CO	Ha		
(13)	H ₉ C N N CH ₉			
(14)	Q078			
(15)	BarB			

[0023]

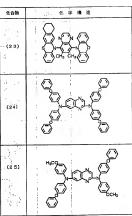
化合物	化 学 構 造
	H ₉ C CH ₃
(16)	H ₆ C CH ₆ H ₇ CH ₇
()	
(17)	
40° (80°)	

[0024]

. - ×: 1

化合物	化学構造 . 1.
(e r)	H-C CH
(20)	C3H6 NO C3H6
(21)	
(22)	

[0025]



[0026] 有機Eし業子は、陽極と陰極間に一層もしくは多層の有機化合物薄膜を形成した業子である。層型の場合、陽極と陰極の間に発光層を設けている。高 光層は、発光材料を含有し、それに加えて陽吸から注入した電子を発光材料まで も過去させるために正孔注入材料もしくは電子法入材料を 含有しても良い。多層型は、「器種ノ正孔注入層、分極 層、陰極)、(陽極ノ発光層、等注入内料を 層、陰極)、(陽極ノ発光層、下注入層、

(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/院積)の参 層構成で排層した有機を止張子がある。本発明の一般式 [1]で示される化合物は、固体状態において強い蛍光 を持つ化合物であり電景系光性に優れているので、発光 材料として発光層内で使用することができる。また」一 参式 [1] の化合物は、発光層内においてドーピング材 料として発光層中にて最適の割合でドーピングすること により、高い発光効率および発光波長の最適な選択が可 能である。ここで、正孔注入層、発光層、もしくは電子 注入層は、それぞれ二層以上で形成されても良い。 [0027]発光層のホスト材料に、ドーピング材料

[0027]発光層のホスト材料に、ドービング材料 (ゲスト材料)として一般式 [1] の化合物を使用して、発光類度が高い有機 E に楽子を得ることもできる。 一般式 [1] の化合物は、発光層内において、ホスト材料に対して0.001重量%~50重量%の範囲で含有されていることが望ましく、更には0.01重量%~10電量%の影面が効果的である。

【0028】一般式 [1] の化合物と併せて使用できる

(9)

ールにペンゾテアゾール金属舗体、ペンゾオキサゾール 金属舗体、ペンゾイミダゾール金属舗体、トリアゾー ル、イミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 スチルベン、ブタジエン、ベンジジン超トリフェニルア ミン・スチリルアミン型トリフェニルアミン、ジアミン Bドリフェニルアミンフルオレノン、ジアミノアントラ セン想トリフェニルアミン、ジアミノフェナントレン型

ホスト材料としては、キノリン金属錯体、オキサジアゾ

型トリフェニルアミンフルオレンシ、シアミノアントン セン烈トリフェニルアミン、グアミノフェナントレン型 トリフェニルアミン、アントラキノジメタン、ジフェノ キノン、チアジアゾール、デトラゾール、ベリレンテト ラカルボン酸・プレオレニリデンメタン、アントラキノ ジメタン、トリフェニレン、アントロン等とそれらの誘 海体、さまび、ボリビールカルバソール、ボリンラン等 の導電性高分子の高分子材料等がある。**

【0029】一般式[1]と共に更なるドーピング材料 を使用して発光色を変化させることも可能となる。一般 ・式[1]と共に使用されるドーピング材料としては、ア ントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テ トラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペリ レン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペリノン、 · フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルブタジ エン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、オキサジ アゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビスス チリル、ピラジン、シクロペンタジェン、キノリン金属 錯体、アミノキノリン金属鏡体、イミン、ジフェニルエ チレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルパゾール、 ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、イミ ダゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリド シ.: ルブレン等およびそれらの誘導体があるが、これら に限定されるものではない。

【0030】 発光層には、発光材料およびドーピング材料に加えて、必要があれば正孔注入材料や電子注入材料を使用することもできる。

[0031] 有機巨L票子は、多層構造にすることによい、クエンテングによる環度や時命の低下を防ぐことができる。また、必要があれば、発光材料、ドーピング材料、キャリア注入を行う正孔注入材料や電子注入材料を工程預以上組み合わせて使用することも出来る。また、正孔注入層、発光層、電子上入層は、大布工層以上の層構成により形成されても良く、正孔もしくは電子が効率よく電極から注入され、層中で輸送される素子構造が誤訳される。

【0032】有機巨し素子の陽極に使用される等電性料 料は、4eVより大きな仕事関数を持つものが好面であ り、炭素、アルミニウム、パケジウム、鉄、コバルト、 ニッケル、タングステン、銀、金、白金、パラジウム等 およびぞれらの含金、ITO基板、NES名種を称され る酸化スズ、酸化インジウム等の酸化金属、さらには ポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が用 いちれる。接触に使用される電電性材料は、4eVより 小さな仕事関数を持つものが好適であり、マグネシウム、カルシウム、銀、館、チタニウム、イットリウム、リチウム、ルーニウム、マンガ・等およびそれ。の合金が用いられる。合金としては、マグネシウムノ銀、マグネシウムノインジウム、リチウムノアルミニウム等が代表例として挙行もれるが、これらに関定されるものではない。合金の比率は、加熱の退度、雰囲気、東空度により制御され渡切な比率が選択される。陽極および除極は、多要があれば二層以上の層様成により形成されていても良い。

(Q.033) 有機Eし素子では、効率良く発光させるために、少なくもも一方は素子の発光波長値線において充分透明であることが望ましい。また、透板も透明であることが望ましい。 遊りを性は、上記の導電性対解を使用して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の選先性を確保するように設定する。発光面の電極は、光透過率を10%以上にすることが望ましい。基板は、機関的、勢的強度を有し、透明であれば規定されるものではないが、例示すると、ガラス基板、ポリエチレン板、ポリエーテルサルフォン板、ポリプロピレン板等の透明性制度があげられる。

【0034】本発明に係わる有機Eし素子の各層の形成 は、真空無常、スパッタリング等の充式成膜法やスポンコーティング、ディッピング等の適式成膜法やスポンコーティング、ティッピング等の適式成膜法のいまれる 力法を適用することができる。域膜は特に限定されるものではないが、各層は造切な誤摩に設定する必要がある。誤解が解すぎると、一定の光出力を得るために大きるとピンホール等が発生して、電界を印加しても充分な 免光質度が得られない。通常の膜厚は5 nmから10 μ mの範囲が適しているが、10 nmから0.2 μmの範囲が含しているが、10 nmから0.2 μmの範囲が含むたけましい。

【0035】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、クロロホルム、テトラモドロラン、ジオキサン等の適切な溶膜に溶解また比が散して薄膜を増充するが、その溶媒はいずれであっても良い。また、いずれの薄膜はおいずれである。 しまない。このような樹脂としては、ポリステレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリステレン、ボリカーボネート、ポリアリレート、ボリメテルメタクリレート、ポリテルフィン、ボリメテルメタクリレート、ポリアリアクリレート、ボリメテルメクシー等の光環性が開、ボリー別、プリアクリレート、セルロース等の絶縁性傾派、ボリー別、ボリチアクリレート、ボリッチの実際性関派、ボリー別、ボリチアンでの実際性関派を挙げることができる。また、近か利としては、酸比的止耗、紫外線吸収制、可等的等を挙げることができる。また、活力が対象ととができる。また、活力が対象とないできる。また、活力が対象を受けることができる。また、活力が対象を受けることができる。また、活力が対象を受けることができる。また、活力が対象を受けることができる。また、新力等を挙げることができる。また、変外線吸収制、可能力を対象を受けることができる。また、変別を対象を受けることができる。また、新力が対象を受けることができる。また、変別を対象を受けることができる。また、変別を対象を受けることができる。また、変別を対象を受けることが表現を使りません。

【003.6】 正孔注入材料としては、正孔を注入する能力を持ち、発光層または発光材料に対して優れた正孔注 入効果を有し、発光層で生成した励起子の電子注入層または電子注入材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の 優れた化合物が挙げられる。具体的には、フタロシアニン系化合物、ナフタロシアニン系化合物、ポルフィリンス・化合物、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、デシルとドラゾン、ボリアリールアルカン、ヒアラゾン、アシルとドラゾン、ボリアリールアルカンズステルルペン、ブタジエン、ペンジジン型ドリフェニルアミン、メテリルアミン型トリフェニルアミン、ジアミン型ドリフェニルアミン、ボリアリール、オリステンツを、それらの誘導体、およびポリピニルカルバゲール、ポリジラン、導電性高分子等の高分子材料等があるが、これらに限定されるものではない。

正孔注入材料の中で、さらに効果的な正孔注入材料は、 芳香族三級アミン誘導体もしくはフタロシアニン誘導体 である。具体的には、ドリフェニルアミン、ドリトリル アミン、トリルジフェニルアミン、N、N ージフェニ ルーN、N'ヾージ(3ーメチルフェニル)ー 1、1'・-ピフェニルー4. 4' ージアミン、N. N. N', N' ーデトラ (4ーメチルフェニル) ー1、1'ーピフェニ ルー4, 4' ージアミン、N, N, N', N' ーテトラ (4 - メチルフェニル) ー1, 1' ーピフェニルー4, 41 ージアミン、N, N' ージフェニルーN, N' ージ ナフチルー 1 11 12 ビフェニルー4. 4' ージアミ ン、N N ージ(メチルフェニル)ーN N ージ (4-n-ブチルフェニル) ーフェナントレンー9、1 0 ージアミン、1、 THEEス [N, Nージ (トリルアミ ノ) フェニル] シクロヘギサン等、もじくはこれらの芳 香族三級アミン骨格を有したオリゴマーもしくはポリマ 一等があるが、これらに限定されるものではない。フタ ロシアニン (Po) 誘導体としては、H2Po、CuP c, CoPc, NiPc, ZnPc, PdPc, FeP c. MnPc. CIAIPc. CIGaPc. Clin Po, CIShPo, CI2SiPo, (HO) AIP c. (HO) GaPc, VOPc, TiOPc, MoO Pc、GaPc-O-GaPc等のフタロシアニン誘導 体およびナフタロシアニン誘導体等があるが、これらに 限定されるものではない。

 されるものではない。また、正孔注入材料に電子受容物 質を、電子注入材料に電子供与性物質を添加して増感させることもできる。

【0039】本発明の有機EL素子において、さらに効 里的な電子注入材料は、金属錯体化合物もしくは含窒素 五員環誘導体である。具体的には、金属錯体化合物とし ては、8--ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス(8 ーヒドロキシキノリナート) 亜鉛、ビス (8-ヒドロキ ・シキノリナート) 飼、ピス (8-ヒドロキシキノリナー ト) マンガン、トリス (8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム、トリス (2-メチルー8-ヒドロキシキ ノリナート) 『アルミニウム、トリス(8ーヒドロキシキ ノリナート) ガリウム、ビス (10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナート) ベリリウム、ビス(10ーヒドロ キシベンゾ [h] キノリナート) 亜鉛、ビス (2ーメチ ルー8ーキノリナート) クロロガリウム、ピス(2〜メ チルー8ーキノリナート) : (oークレゾラート) ガリウ ム、ビス(2ーメチルー8ーキノリナート)(1一ナフ トラート) アルミニウム、ビス (2-メチルー8-キノ リナード) (2ーナフトラート) ガリウム等があるが、 これらに限定されるものではない。また、含窒素五具誘 導体としては、オキサゾール、チアゾール、オキサジア ・ゾール、チアジアゾールもしくはトリアゾール誘導体が 好ましい。

【0040】具体的には、2,25~ピス(1-フェニ ル) -1, 3, 4-オキサゾール、ジメチルPOPO P、2、5ーピス (1ーフェニル) -1、3、4ーチア ゾール、2、5ービス (1ーフェニル) -1、3、4-オキサジアゾール、2ー(4'ーtertーブチルフェ ニル) -5-(4" ーピフェニル) 1、3、4ーオキサジ アゾール、2. 5ーピス(1ーナフチル)-1. 3. 4 ーオキサジアゾール、1, 4ービス [2-(5-フェニ ルオキサジアゾリル)] ベンゼン、1,4-ビス-[2-(5ーフェニルオキサジアゾリル)] ー 2 ー t e r t ーブ チルベンゼン、2ー(4'ーtert‐ブチルフェニ ル) -5-(4* ービフェニル)-1, 3, 4ーチアジア ゾール、2, 5ーピス (1ーナフチル) -1, 3, 4-チアジアゾール、1、4ーピス [2-(5-フェニルチ アジアゾリル)] ベンゼン、2ー(4'ーtcrtーブ チルフェニル) -5-(4"-ピフェニル)-1:3:4ートリアゾール、2、5ービス(1ーナフチル)-1、 4ートリアゾール、1、4ーピス[2-05-フェ ニルトリアゾリル)] ベンゼン等があるが、これらに限 定されるものではない。 - - * TULA TE IRE

[0041] 本有機EL素子においては、発光層中に、一般式[中]の化合物の他に、発光材料、ドーピング格 料、正孔法人材料および電子注入材料の少なくとも1種 が同一層に含有されてもよい、また、本発明により得ら れた有機EL裏子の、温度、温度、雰囲気等に対する安 定性の時上のために、素子の表面に保護層を設けたり、

シリコンオイル、樹脂等により素子全体を保護すること も可能である。

【0042】以上のように、有機EL素子の発光層に本 発明の化合物を用い、更には特定の正孔注入層もしくは 電子注入層と組み合わせることにより、発光効率、最大 発光輝度等の有機EL素子特性を改良することができ た。また、この素子は熱や電流に対して非常に安定であ り、さらには低い駆動電圧で実用的に使用可能の発光線 度が得られるため、従来まで大きな問題であった劣化も 大幅に低下させることができた。

【0043】本発明の有機EL素子は、壁掛けテレビ等 のフラットパネルディスプレイや、平面発光体として、 複写機やプリンダー等の光源、液晶ディスプレイや計器 類等の光源、表示板、標識灯等へ応用が考えられ、その - 工業的価値は非常に大きい。 タイカー・デ

[0044] 本発明の材料は、有機EL素子、電子写真 脱光体、光電変換素子、太陽電池、イメージセンサー等 の分野においても使用できる。 [00]45] 15时报集 17. 11.

【実施例】以下、本発明を実施例に基づきさらに詳細に 説明する。なお、説明中の部は重量部を表す。 化合物(2)の合成方法 ペースしゅう

コケ(3)デジメチルニ2 ペイミダゾリジノン5 0部中に、 「5. 38. ラジブロモキノキサリンフ. 2部、p\rp': -ジ ドリルアミン16:2部、および炭酸カリウム12部、 鋼粉 0. 5 部を入れ、2 0.0℃にで5.0時間加熱撹拌し た。その後、500部の水で希釈した。酢酸エチルで抽 出を行い、濃縮して、サジリカゲルを用いたカラムクロマ トグラフィーにより精製を行ない白色の蛍光を有する粉 末12部を得た。FD-MSよる分子量分析により、化 合物(2)であることを確認した。

【0046】化合物(3)の合成方法 1. 3ージメチルー2ーイミダゾリジノン50部中に、 5.8-ジブロモキノキサリン6.0部、1ーナフチル ーフェニルアミン 1、2、☆2部、および炭酸カリウム 8 部、銅粉0.5部を入れ、200℃にて50時間加熱撹 拌した。その後、500部の水で希釈した。酢酸エチル で抽出を行い、濃縮して、シリカゲルを用いたカラムク ロマトグラフィーにより精製を行ない白色の蛍光を有す る粉末13部を得た。FD-MSよる分子量分析によ り、化合物(3)であることを確認した。

[0047] 化合物 (16) の合成方法...

1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノン30部中に、 2、6-ジプロモキノキサリン8部、ジ(4-(1.1) ージメチルー1ーフェニル) メチルフェニル) アミン3 5部、および炭酸カリウム10部、鋼粉0.5部を入 れ、200℃にて50時間加熱撹拌した。その後、50 O部の水で希釈し、この後、酢酸エチルで抽出を行い、 濃縮し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー により精製を行ない白色の蛍光を有する粉末15部を得 た。FD-MSよる分子量分析により、化合物(16) であることを確認した。以下に本発明の化合物を用いた 実施例を示す。本例では、電極面積2mm×2mmの有 機EL素子の特性を測定した。

【0048】実施例1 洗浄したITO電極付きガラス板上に、発光材料として 表1の化合物(2)、2.5-ビス(1-ナフチル)-1. 3. 4ーオキサジアゾール、ポリカーボネート樹脂 (帝人化成:パンライトK-1300) を5::3:2の 重量比でテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーテ ィング法により膜厚100nmの発光層を得た。その上 に、マグネシウムと銀を10、1で混合した合金で煙厚 150nmの電極を形成して有機EL素子を得た。この 素子の発光特性は、直流電圧5Vで100(o.d/ m2) 、最高輝度1000 (od/m2) 、発光効率0. 60 (Im/W) の発光が得られた。 洗浄したITO電極付きガラス板上に、N. N. ージ (3-メチルフェニル) -N, N'-ジフェニル-1. 1-ビフェニル-4、4-ジアミン(TPD)を真空蒸 着して、膜厚20nmの正孔注入層を得た。次いで、化 合物(2)を蒸着し膜厚40nmの発光層を作成し、ト リス (8-ヒドロキシキノリン) アルミニウム錯体 (A Iq3)を蒸着し、膜厚30nmの電子注入層を得た。 その上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金 で膜厚100mmの電極を形成して有機EL素子を得 た。正孔注入層および発光層は1·0-6Torrの真空中 で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子は直流 響圧5 Vで発光輝度110 (c/d/m²)、最大発光輝 度11000 (cd/m2)、5 Vの時の発光効率1. (Im/W)の青色発光が得られた。

[0050] 宇施例3

洗浄した I T O電極付きガラス板上に、化合物 (11) を塩化メチレンに溶解させ、スピンコーティング法によ り膜属50nmの正孔注入型発光層を得た。次いで、ビ ス (2-メチルー8-キノリナート) (1-ナフトラー ト) ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚10nmの電子注 入層を作成し、その上に、マグネシウムと銀を10:1 で混合した合金で膜厚100mmの電極を形成して有機 EL素子を得た。発光層および電子注入層は10-6To rrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。こ の素子は、直流電圧5 V で200 (cd/m²) 、最高 輝度1200 (cd/m²)、発光効率0.70 (lm /W) の青緑色発光が得られた。

【0051】実施例4

洗浄した [TO電極付きガラス板上に、化合物(3)を 真空蒸着して、膜厚50nmの正孔注入型発光層を得 た。次いで、ビス(2ーメチルー8ーキノリナート) (1-ナフトラート) ガリウム錯体を真空蒸着して膜厚 10 nmの電子注入層を作成し、その上に、マグネシウ ムと銀を10:1で混合した合金で展降100nmの電 機を形成して有機と、乗子を得た。発光層および電子注 入層は10-frorrの真空中で、基板温度登温の条件 下で蒸着した。この素子は、直流電圧5Vで300(c d/m²)、最高程度10200(c3/m²)、発光効 率1:160(m/w)の発光が得られた。

[0052] 実施例5~20

洗浄した ITO 電極付きガラス板上に、下記化学構造で 示される化合物 (266) を真空蒸煮して、膜厚20 nm に正孔注入層を形成した。次いで、発光材料として、表 1 の化合物を真空蒸煮して膜厚20 nmの発光層を得 せ。次いで、ピズ(2 ーメチルー8 ーキノリケート)

(1ーナフトラート)。ガリウム錦体を真空蒸煮して膜厚 10mmの電子注入層を作成じ、その上に、マグネシウ た態度です。1 で混合した合で設厚す10mmの電 種を形成して有機目し素子を得た。。正孔注入層および発 光層は10-670mの真空中で、当板温度整理の条件 で高差した。この素子の発光特性を表えに示す。ここ での発光輝度は、直流電圧5 V即可時の輝度である。本 実施例の有機目し素子は、全て最高輝度10000(c つ/㎡/)以上の高輝度特性を有し、また、青色から縁 色の発光色を構态ごとができた。

色の完元色を得ることができた。 【0053】化合物(26)

[0054]

[化3]

【0055】 【表2】

化合物	発光輝度 (cd/m")	発光効率 (1 m/W):	
(1)	320	3. 1	
	260		
	340		
	420		
	250	26	
	280	2. 5	
	320	3. 0	
		2. 1.	
	350	2.8	
(1.2)			
(1.4)			
	270	2.6	
	(1) (2) (3) (4) (6) (7) (10) (11) (12) (13) (1,4) (16) (17) (18)	(ca/m) (1) 320 (2) 250 (3) 340 (4) 429 (6) 250 (7) 250 (10) 360 (11) 350 (12) 350 (13) 410 (14) 360 (16) 410 (17) 280	(cd/m) (lm/w). (1) 320 8.1 (2) 280 2.5 (3) 340 3.2 (4) 420 2.6 (6) 250 2.6 (7) 280 2.5 (10) 200 2.1 (11) 210 2.1 (12) 380 2.8 (14) 360 3.3 (16) 410 3.5 (17) 280 2.2 (17) 280 2.8

【0056】実施例21

洗浄した I T O 策極付きガラス板上に、4、4′、4″ ートリス [N-(3-メチルフェニル) ー N ー フェニル アミノ] トリフェニルアミンを真空蒸着して、膜厚40 nmの正孔注入層を得た。次いで、4,4′ーピス [N

10 の報告を物(26)との間は、無金属フタロシアニンの原厚5 nmの正孔注入層を設ける以外は、実施例3と同様の方法で有機巨に基子を作業じた。この素子は、直流電圧5 Vで1000(6 d/m²)、最高輝度13000(cd/m²)、発光効率1、20(1m/W)の青緑色発光が得られた。

[0058]実施例23世代ルール はり、はり、はり、4、4、4、4・トリス [N-世(3-世がアルフェデル) Nープをエルアミソントリウェニルアミンの代わりに 報金属フタロシアニンの議算 20.1mの正孔注入層を設ける以外は、実施例21と同様の方法で有機日に第千を代観した場合の発行は、一直流電圧5-Mで220(e.d/m²):最高線底12000年代の日本の一般の発売があり、1、10(lin/W):の青緑色泉光が得られたいと、「0059]実施例24:1、10(lin/W):の青緑色泉光が得られたいと、

発光限とじて、化合物(1.2):化合物(2.7):を1: 1000割合で添着した膜厚10mmの正孔注入層を設 方包以外は、実施例21と同様の方法で有膜Eし架子を 作態した。この来子は、直接電圧5Vで1000(cd /m²)、最高輝度18000(cd/m²)、発光効率 1.50(1m/2/m)の青蛙色祭光が得られた。

[0060] 化合物(27)

14-41:

【0062】 実施例25

発光層として、化合物(16):ピス(2ーメチルー8 ーキノリナート): (フェノラート) ガリウム線体を1: 100の割合で蒸着した順厚10nmの正孔注入層を設 ける以外は、実施例21と同様の方法で有機Eし来子を 作製した。この素子は、直流電圧5Vで400(cd/ m²)、最高輝度 1 1 0 0 0 (c d / m²) 、発光効率
1. 10 (l m / w) の青色泉光が得られた。
[0 6 6 3 | 本集例で示された有機 E L 案干化、二層
型以上の素子構成において、最大発光輝度 1 0 0 0 (c d / m²) 以上の泉光が得られ、高い泉光効率を得
る とができた、本実施例で示された有機 E L 薬干に
ついて、3 (m A / c m²) で連続泉光させたところ、
1 0 0 0 時間以上安定な泉光を観測することができた。
未発明の有機 E L 素子は泉光効率、発光類度の向上と長

寿命化を達成するものであり、併せて使用される発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料、電子注入材料、電 感剤、樹脂、電極材料等および素子作製方法を限定する ものではない。

[0064]

[発明の効果] 本発明の有機EL用発光材料を発光材料 として使用した有機EL索子は、従来に比べて高い発光 効率で高輝度の発光を示し、長寿命の有機EL素子を得 ることができた。